

Содержание

Материалы и компоненты изделий электронной техники

Исследование влияния легирования буферного слоя GaN углеродом и железом на эффект вытеснения носителей заряда из буфера в область канала нормально открытых HEMT AlGaN/AlN/GaN-транзисторов

Тхан Пьо Чжо, Егоркин В.И., Корнеев В.И., Мьо Мин Тхант

5

Исследование влияния легирования буферного слоя GaN углеродом

на эффект лавинного пробоя нормально открытых HEMT AlGaN/AlN/GaN-транзисторов

Тхан Пьо Чжо

16

Моделирование биологических процессов. Методы и приборы

Оценка дозовых нагрузок мышевидных грызунов загрязненных территорий ближней зоны Чернобыльской АЭС

Желтоножская М.В., Желтоножский В.А., Липская А.И., Никитин А.Н., Розанов В.В., Черняев А.П., Васильев А.Б.

24

Математическое моделирование физико-технических систем

Модель нейросетевой адаптивной системы для цифрового контура управления электроприводом

Непомнящий О.В., Тарасов А.В., Краснобаев Ю.В., Хайдукова В.Н., Непомнящий Д.О.

34

Перспективные технологии бронезащиты: модели, материалы, конструкции

Сериков С.В., Устинов И.К., Коржавый А.П.

43

Информационные технологии и оптимизация

Оценка качества машинного перевода на основе ансамблевых методов машинного обучения

Козина А.В., Белов Ю.С.

52

Перспективность внедрения нейросетевых технологий в системы обработки радиолокационной информации

Егорова Е.В., Рыбаков А.Н., Аксяитов М.Х.

59

Проблемы экономики

Анализ перспектив внедрения экономики замкнутого цикла на территории Российской Федерации на примере Калужской области

Никулина С.Н., Чериканова Е.А., Челенко А.В., Гришакова В.В.

69